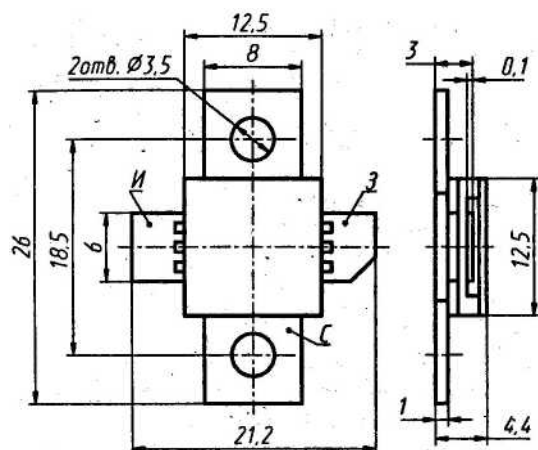


A724A, A724Б, A724B, A724Г



Транзисторы кремниевые полевые эпитаксиально-планарные с изолированным затвором и индуцированным каналом л-типа. Предназначены для применения в переключательных и импульсных устройствах. Выпускаются в металло-керамическом корпусе с полосковыми выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 6 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.

Электрические параметры

Крутизна характеристики при $U_{си} = 30 \text{ В}$, $I_c = 1 \text{ А}$ ($t_u = 600 \text{ мкс}$, $Q = 200$), не менее	750 мА/В
Начальный ток стока при $U_{си} = 30 \text{ В}$, $U_{зи} = 0$, не более	7 мА
Остаточный ток стока при $U_{си} = U_{си_макс}$, $U_{зи} = 10 \text{ В}$, не более	10 мА
Ток стока при $U_{си} = 30 \text{ В}$, $U_{зи} = 25 \text{ В}$ ($t_i = 600 \text{ мкс}$, $Q = 200$), не менее:	
A724A	2,6 А
A724Б, A724B	3 А
A724Г	3,5 А
Сопротивление сток—исток в открытом состоянии при $U_{зи} = 20 \text{ В}$, $I_c = 0,5 \text{ А}$, не более:	
A724A	5 Ом
A724Б, A724B, A724Г	4,5 Ом

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток—исток ¹ при $T_k = -60...+100 \text{ °C}$:	
A724A	1000 В
A724Б	800 В
A724B	700 В
A724Г	600 В
Постоянное напряжение затвор—исток	30 В
Постоянное напряжение затвор—сток при $T_k = -60...+100 \text{ °C}$:	
A724A	1010 В
A724Б	810 В
A724B	710 В
A724Г	610 В
Потенциал статического электричества	200 В
Постоянная рассеиваемая мощность ² :	
$T_k = -60...+35 \text{ °C}$	60 Вт
$T_k = +125 \text{ °C}$	17,5 Вт
Температура окружающей среды	$-60...T_k = +125 \text{ °C}$

1 При $T_k = +100...+125 \text{ °C}$ напряжение снижается линейно до 800 В для A724A и до 650 В для A724Б.

2 При $T_k > +35 \text{ °C}$ максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность снижается линейно

Минимальное расстояние от корпуса до начала изгиба выводов 3 мм. Минимальное расстояние от места пайки по длине вывода 3 мм, температура припоя $+260 \pm 5 \text{ °C}$, время пайки не более 3 с.

При установке в аппаратуре транзистор должен плотно прилегать к теплоотводу, шероховатость контактной поверхности теплоотвода должна быть не более 1,6 мкм, неплоскостность не более 0,02 мм.

Допускается параллельное включение транзисторов без выравнивающих элементов при $U_{зи} = 15 \text{ В}$